— ФИЗИКА —

УЛК 538.958

СИНТЕЗ КОМПОЗИТОВ АЛМАЗ- ${ m SiO_2}$ СО СВОЙСТВАМИ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА

© 2023 г. Д. Н. Совык^{1,*}, К. А. Одинцов^{2,3}, А. П. Большаков¹, С. А. Дьяков⁴, С. С. Савин^{1,3}, И. А. Федорова¹, В. Ю. Юров¹, В. М. Масалов^{1,5}, В. Г. Ральченко^{1,**}, академик РАН В. И. Конов¹

Поступило 21.06.2023 г. После доработки 21.06.2023 г. Принято к публикации 03.07.2023 г.

Сообщается о синтезе периодических структур в виде композита монокристальный алмаз-опал ${
m SiO_2}$ со свойствами фотонного кристалла в видимой области спектра.

Ключевые слова: фотонный кристалл, алмаз, опал, химическое осаждение из газовой фазы, композит, спектр отражения

DOI: 10.31857/S2686740023050127, EDN: UQCDJZ

1. Фотонные кристаллы (ΦK) — среды с периодически модулированным показателем преломления света, позволяют управлять световыми потоками, усиливая, ослабляя или разделяя их. Алмаз является одним из немногих материалов для создания ФК видимого диапазона благодаря высокому показателю преломления (n = 2.4) и оптической прозрачности, обладая при этом высокими прочностью, теплопроводностью, наличием центров окраски, таких как примесно-вакансионные центры NV, SiV, GeV, которые, будучи встроены в фотонный кристалл, обнаруживают повышенную яркость [1, 2]. Однако изготовление ФК из монокристального алмаза стандартными методами травления встречает многочисленные проблемы ввиду химической стойкости материала. С использованием плазменного травления до сих пор реализовать удалось лишь одномерные ФК в виде балки [2] и двумерные алмазные ФК [3].

Ранее трехмерные ΦK из нанокристаллического алмаза были получены заращиванием алма-

зом пустот в темплате из объемного опала (периодической структуры из субмикронных сфер SiO₂, получаемой путем самосборки в виде гранецентрированной кубической решетки) в процессе осаждения из газовой фазы (CVD-метод) [4-6]. Доля пустот в опале составляет 26%. Рост алмаза в порах в этом случае происходит на специально привносимых центрах кристаллизации - наночастицах алмаза на поверхности сфер, и, поскольку наночастицы-зародыши всегда случайно ориентированы, синтезируемый алмаз оказывается принципиально нанокристаллическим. Предпочтительным, однако, является создание ФК из монокристаллического алмаза, что позволило бы минимизировать потери из-за поглощения на дефектах и рассеяния на границах зерен.

Концепция изготовления монокристального Φ K в виде композита алмаз-SiO₂ основана на эпитаксиальном проращивании алмаза методом CVD сквозь поры опалового слоя, уложенного на алмазной подложке, что было продемонстрировано для случая монослоя сфер SiO₂ [7]. В настоящей работе мы сообщаем о первой реализации этого подхода для опаловых пленок толщиной несколько монослоев сфер (порядка 10 слоев), изготовлении "запечатанных" в толще алмаза опаловых структур. Показано, что синтезированные композиты обладают свойствами Φ K, демонстрируют брэгговский пик в спектрах отражения.

2. Схема получения композита опал-алмаз показана на рис. 1. Опаловые пленки наносили из водной суспензии монодисперсных сферических частиц ${\rm SiO_2}$ диаметром 245.3 \pm 3.5 нм на полированные подложки монокристаллов синтетиче-

¹Институт общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, Россия

² Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

³МИРЭА— Российский технологический университет, Москва, Россия

⁴Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

⁵Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук, Черноголовка, Московская обл., Россия

^{*}E-mail: sovyk@nsc.gpi.ru

^{**}E-mail: vg ralchenko@mail.ru

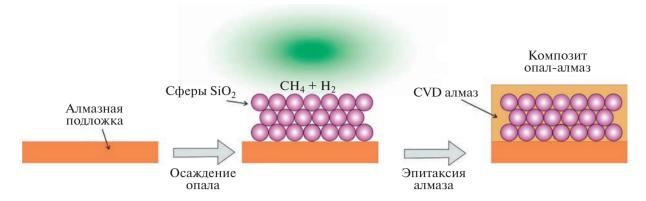


Рис. 1. Схема получения композита опал-алмаз путем эпитаксии и проращивания алмаза в СВЧ-плазменном реакторе сквозь поры в опаловой пленке на подложке из алмазного монокристалла.

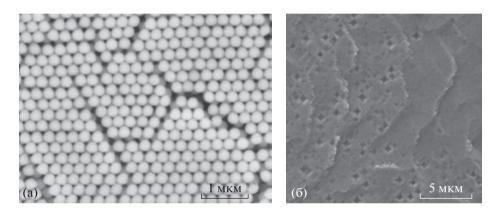


Рис. 2. Изображение в растровом электронном микроскопе поверхности опаловой пленки толщиной 4 монослоя сфер SiO_2 до (a) и после (б) осаждения алмаза.

ского алмаза с ориентацией основной грани (100). Сферы SiO_2 приготовлены модифицированным двухстадийным методом Штобера—Финка—Бона при гидролизе тетраэтоксисилана (ТЭОС) [8]. Опаловые слои осаждались за счет капиллярных сил на погруженную в суспензию вертикально расположенную подложку [9], вытягиваемую с постоянной скоростью 0.5 мкм/с. Затем образцы отжигали в течение 3 ч в вакууме при 750°С с целью спекания и образования мостиков между сферами, придавая прочность структуре. Полученный образец с числом монослоев сфер N=4 продемонстрировал хорошее упорядочение (рис. 2а).

Эпитаксию алмаза проводили в СВЧ-плазмохимическом реакторе ARDIS-300 (ООО "Оптосистемы") [10] в смеси метан-кислород-водород при условиях: расход $CH_4/O_2/H_2 = 80/20/900$ см³/мин, мощность СВЧ излучения 5.1 кВт, давление 140 Торр, измеряемая пирометром SensorTherm M322 температура подложки 930°С, время осаждения 45 мин. Алмазная пленка полностью проросла сквозь поры в опале и полностью покрыла его (рис. 26). На поверхности алмаза просматри-

ваются террасы, характерные для монокристаллического CVD-алмаза, а также ямки в виде инвертированных пирамид с размером стороны 300-500 нм, соизмеримые с размером одной сферы SiO_2 , которые могут формироваться из-за локального отставания процесса заращивания [7].

3. Спектры отражения образцов до и после осаждения алмаза измеряли при углах падения света $\theta=15^\circ$ на спектрометре HR4000 OceanOptics. Найдено, что для исходного опала и выращенного композита сохраняется высокая упорядоченность структуры, дающая для грани (111) брэгговское отражение света на длине волны $\lambda_{\max(111)}$, характерное для Φ K:

$$\lambda_{\max(111)} = 2d_{111} \cdot \sqrt{\varepsilon_{eff} - \sin^2 \theta},\tag{1}$$

где $d_{111}=0.816~D$ — период решетки опала со структурой ГЦК, состоящей из сфер диаметром D=245 нм, ϵ_{eff} — эффективная диэлектрическая проницаемость Φ K, $\epsilon_{eff}=\epsilon_{SiO2}f+(1-f)$ ϵ_{air} , f=0.74 — коэффициент заполнения пористой структуры, θ — угол падения света (0° при нормальном падении).

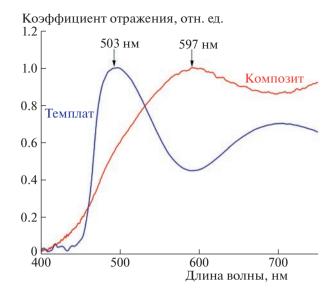
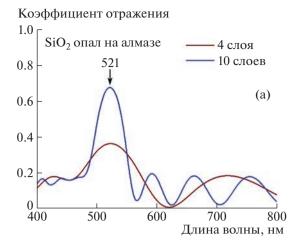


Рис. 3. Спектры отражения для исходного темплата опал-на-алмазе и композита опал-алмаз (нормированы на единицу). Брэгговский пик $\lambda_{max(111)} = 597$ нм для композита смещен в красную сторону по отношению к темплату вследствие увеличения ϵ_{eff} .

Для исходной опаловой пленки после отжига при 750°С $n_{\rm SiO2} = (\epsilon_{\rm SiO2})^{1/2} = 1.396$ и $\epsilon_{\rm SiO2} = 1.95$, $\epsilon_{\it eff} = 1.703$ и при $\theta = 15^\circ$ величина по формуле (1) $\lambda_{\rm max}$ составляет 512 нм, что близко к измеренному положению пика отражения на 503 нм (рис. 3). При заполнении алмазом (n = 2.40) пор в опале положение брэгговского пика смещается в красную сторону до $\lambda_{\rm max} = 597$ нм (рис. 3) вследствие увеличения $\epsilon_{\it eff}$ до 2.296. Однако этот сдвиг не достигает величины $\lambda_{\rm max} = 671$ нм, следующей из (1), что мы связываем с контракцией периода опаловой матрицы и уменьшения доли (1 - f) объема пор при дополнительном спекании в процессе осажления алмаза.

Моделирование спектров отражения полученных ФК выполнено методом матрицы рассеяния, основанном на Фурье-модальном методе [11]. Структура ФК разбивалась на элементарные плоские слои, периодические в направления х и у [12]. Одна сфера разбивалась на 30 слоев. Решение уравнений Максвелла в каждом слое производили путем разложения электромагнитных полей на пространственные Фурье-гармоники (всего 169 гармоник). При расчете проводилось усреднение по поляризации падающего излучения. В результате вычислялась матрица рассеяния, которая содержит полную оптическую информацию о структуре. Число монослоев N для сфер диаметром 245 нм меняли от 1 до 10, с целью проследить приближение спектров отражения к таковым для объемной структуры. Изменение периода опаловой структуры за счет отжига в процессе заполнения пор алмазом не учитывали.



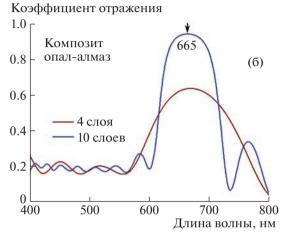


Рис. 4. Расчетные спектры отражения для системы опал-на-алмазе (а) и композита алмаз-опал (б) с числом монослое в сфер N=4 (коричневая линия) и N=10 (синяя линия). Диаметр сфер 245 нм, период $d_{111}=199.9$ нм.

Расчетные спектры отражения для системы опална-алмазе и композита алмаз-опал с числом монослоев сфер N=4 и N=10 представлены на рис. 4. Брэгговский пик для опала находится на 521 нм (рис. 4а), что близко к измеренной величине, причем для N=4 коэффициент отражения R составляет около 0.35, а для N=10 возрастает до 0.67. Для композита пик отражения имеет место при 665 нм (рис. 46), величина отражения возрастает по сравнению с опалом: R=0.67 для N=4 и R=93 для N=10, т.е. для R=0.67 для сомпозит проявляет свойства объемного R=0.67 для R=0

4. Таким образом, в работе синтезирован композиционный материал с периодической структурой, состоящий из монокристального алмаза и погруженного в него опалового слоя сфер SiO₂. Композит продемонстрировал свойства фотонного кристалла в видимой области спектра. Наш подход открывает путь к созданию инвертированных опалов из монокристального алмаза (путем

химического удаления сфер SiO_2) для фотоники видимого и ИК-диапазона.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность М.С. Комленку за техническую помощь в приготовлении темплатов на алмазе и Ю.М. Крылову за помощь в подготовке статьи к публикации.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, грант № 21-12-00403.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Evans R.E., Bhaskar M.K., Sukachev D.D., et al. Photon-mediated interactions between quantum emitters in a diamond nanocavity // Science. 2018. V. 362. № 6415. P. 662–665. https://doi.org/10.1126/science.aau4691
- 2. *Kuruma K., Pingault B., Chia C., et al.* Coupling of a single tin-vacancy to a photonic crystal cavity in diamond // Appl. Phys. Lett. 2021. V. 118. № 23. P. 230601: 1–6. https://doi.org/10.1063/5.0051675
- 3. Wan N.H., Mouradian S., and Englund D. Two-dimensional photonic crystal slab nanocavities on bulk single-crystal diamond // Appl. Phys. Lett. 2018. V. 112. № 14. P. 141102: 1–4. https://doi.org/10.1063/1.5021349
- 4. Zakhidov A.A., Baughman R.H., Iqbal Z., et al. Carbon structures with three-dimensional periodicity at optical wavelengths // Science. 1998. V. 282. № 5390. P. 897–901.

https://doi.org/10.1126/science.282.5390.897

- Ральченко В.Г., Совык Д.Н., Большаков А.П. и др. Получение прямых и обратных опаловых матриц из алмаза методом осаждения из газовой фазы // Физика твердого тела. 2011. Т. 53. № 6. С. 1069—1071. https://doi.org/10.1134/S106378341106028X
- 6. *Kurdyukov D.A., Feoktistov N.A., Nashchekin A.V. et al.* Ordered porous diamond films fabricated by colloidal crystal templating // Nanotechnology. 2012. V. 23. № 1. P. 015601:1–8. https://doi.org/10.1088/0957-4484/23/1/015601
- 7. *Dai B., Shu G., Ralchenko V. et al.* 2D inverse periodic opal structures in single crystal diamond with incorporated silicon-vacancy color centers // Diam. Relat. Mater. 2017. V. 73. P. 204–209. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2016.09.022
- Масалов В.М., Сухинина Н.С., Емельченко Г.А. Коллоидные частицы диоксида кремния для формирования опалоподобных структур // Физика твердого тела. 2011. Т. 53. № 6. С. 1072—1076. https://doi.org/10.1134/S1063783411060229
- 9. Lange B., Fleischhaker F., Zentel R. Functional 3D photonic films from polymer beads // Physica Status Solidi (a). 2007. V. 204. № 11. P. 3618–3635. https://doi.org/10.1002/pssa.200776401
- Bolshakov A.P., Ralchenko V.G., Shu G., et al. Single crystal diamond growth by MPCVD at subatmospheric pressures // Materials Today Communications. 2020. V. 25. P. 101635: 1–10. https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2020.101635
- 11. *Tikhodeev S.G., Yablonskii A.L., Muljarov E.A., Gip-pius N.A., Ishihara T.* Quasiguided modes and optical properties of photonic crystal slabs // Phys. Rev. B. V. 66. № 4. P. 045102: 1–17. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.66.045102
- 12. *Dyakov S.A.*, *Gippius N.A.*, *Voronov M.M.*, *et al.* Quasiguided modes of opaline photonic crystals covered by $Ge_2Sb_2Te_5$ // Phys. Rev. B. 2017. V. 96. P. 045426: 1–7. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.045426

SYNTHESIS OF COMPOSITES DIAMOND-SiO₂ WITH PHOTON CRYSTAL PROPERTIES IN THE VISIBLE

D. N. Sovyk^a, K. A. Odintsov^{b,c}, A. P. Bolshakov^a, S. A. Dyakov^c, S. S. Savin^{a,d}, I. A. Fedorova^a, V. Yu. Yurov^a, V. M. Masalov^{a,e}, V. G. Ralchenko^a, and Academician of the RAS V. I. Konov^a

^aProkhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

^bMendeleev University of Chemical Technology, Moscow, Russia

^cSkolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, Russia

^dMIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia

^eOsypian Institute of Solid State Physics of the Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Moscow Region, Russia

We report on synthesis of periodical structures by chemical vapor deposition in form of a composite "single crystal diamond - SiO₂ nanospheres" which shows photon crystal properties in the visible.

Keywords: photonic crystal, diamond, opal, chemical vapor deposition, composite structure, optical reflection spectrum